400 mW-Z-Dioden und -Stabistoren

Z-Dioden und Stabistoren werden hauptsächlich für Stabilisierungszwecke eingesetzt. Zur Spannungsstabilisierung sind neben ein- und mehrstufigen Schaltungen einfacher Art auch solche in Verbindung mit Transistoren gebräuchlich. Z-Dioden können aber auch als Stromstabilisatoren, zur Ableitung von Kurzschlußströmen bei Überspannung, zum Überlastungsschutz von Zeigerinstrumenten, zur Nullpunktunterdrückung (Bereichsverschiebung) bei Meßinstrumenten sowie zur Erzeugung von Vorspannungen, zur Ankopplung von Verstärkerstufen, zur Amstörbegrenzung von FM-Spannungen und in Verbindung mit einem Relais als Schwellenwertschalter verwendet werden.

Aus dem VALVO-Lieferprogramm stehen hierfür im Leistungsbereich bis 400 mW Z-Dioden für Spannungen von 3,3 bis 75 V und Stabistoren für Spannungen von 1,4 bis 3,6 V zur Verfügung.

Silizium-Planar-Z-Dioden der Typenreihe BZX 79/... mit einer Durchbruchspannung $U_Z = 4,7$ bis 75 V mit einer Toleranz der Durchbruchspannung von $\Delta U_Z = \pm 5$ % (C-Reihe) und $\Delta U_Z = \pm 2$ % (B-Reihe).

Silizium-Legierungs-Z-Dioden der Typenreihe BZY 88/... mit einer Durchbruchspannung $U_Z=3,3$ bis 30 V mit einer Toleranz der Durchbruchspannung von $\Delta U_Z=\pm$ 5 %.

Zur Stabilisierung noch kleinerer Spannungen eignen sich Stabistoren mit 2 bis 5 in Durchlaßrichtung betriebenen in Reihe geschalteten Diodensystemen, die in einem gemeinsamen Diodengehäuse montiert sind.

Stabistoren der Typenreihe BZX 75/... (Siliziumdioden mit engtolerierter Durchbruchspannung) mit einer Durchlaßspannung $U_F = 1,4$ bis 3,6 V und einer Toleranz der Durchlaßspannung von $\Delta U_F = \pm$ 5 %.

Außer den vorstehend aufgeführten Typen enthält das VALVO-Lieferprogramm Z-Dioden mit Verlustleistungen von P = max. 1,3 bis 75 W, wovon wir auf Anforderung gern Datenblätter zur Verfügung stellen.





STABISTOREN

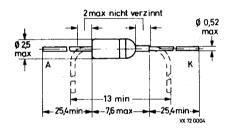
Siliziumdioden mit engtolerierter Durchlaßspannung zur Stabilisierung kleiner Spannungen sowie für Begrenzer- und Schutzschaltungen

Mechanische Daten:

Gehäuse: JEDEC D0-7

Farbring: Katodenseite

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:	BZX 75/C1V4	<u>C2V1</u> <u>C2V8</u>	<u>C3V6</u>
Durchlaßspannung bei I _F = 10 mA	U _F = 1,4	2,1 2,8	3,6 V
Toleranz der Durchlaßspannung	$\Delta U_{\mathbf{F}} \stackrel{\leq}{=}$	± 5	%
Sperfspannung	U _R = max.	10	v
Durchlaßstrom, Scheitelwert	$I_{FM} = max.$	250	mA
Verlustleistung bei ϑ _{II} ≤ 35°C	P = max.	400	mW
Sperrschichttemperatur	$\theta_{J} = \max$	175	°c

BZX 75/C...

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_{J \text{ max}}$)

ope.	 Jui	****	пĕ.				
_							

Durchlaßstrom, Scheitelwert:

Verlustleistung bei
$$\vartheta_{\text{U}} \stackrel{\leq}{=} 35^{\circ}\text{C}$$
:

Sperrschichttemperatur:

$$U_R = max.$$
 10 V

$$I_{FM} = max.$$
 250 mA

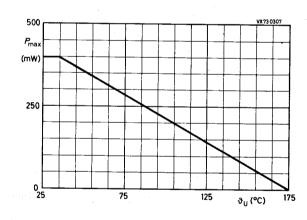
$$\theta_{\rm J}$$
 = max. 175 $^{\rm o}$ C

$$\vartheta_{S} = \min. -65 \circ 0$$
 $\vartheta_{C} = \max. 175 \circ 0$

Wärmewiderstand;

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

0,35 grd/mW



BZX 75/C...

Kennwerte:			BZX 75/C1V4	BZX 75/C2V1	BZX 75/C2V8	BZX 75/C3V	<u>6</u>
Durchlaßspannung						(
bei $I_F = 1 \text{ mA}$:	$\mathbf{u}_{\mathbf{F}}$	=	1,16-1,34	1,75-2,05	2,33-2,70	3,02-3,45	v
bei $I_F = 10 \text{ mA}$:	$\mathbf{U}_{\mathbf{F}}$	=	1,4 (1,33-1,47)	2,1 (1,99-2,21)	2,8 (2,66-2,94)	3,6 (3,42-3,78	v)
Temperaturkoeffizi der Durchlaßspannu				$(x_{i_1}, \dots, x_{i_n})$		•	
bei $I_F = 1 \text{ mA}$:	$\Delta \mathbf{U_F}/\Delta \mathbf{\vartheta_J}$	=	- 4	- 6	- 8	-10 mV	/grd
bei $I_F = 10 \text{ mA}$:	$\Delta \mathrm{U_F}/\Delta \vartheta_\mathrm{J}$	=	-3,3	-5,0	-6,6	-8,2 mV	/grd
Differentieller Widerstand bei f =	· 1 kHz						
bei $I_F = 1 \text{ mA}$:	$\mathbf{r}_{\mathbf{f}}$	=	60	90	120	150	Ω
bei $I_F = 10 \text{ mA}$:	$^{\mathbf{r}}\mathbf{f}$	=	$6 \ (\stackrel{\leq}{=}\ 10)$	9 (= 15)	$12 \stackrel{\leq}{=} 20)$	15 (\leq 25)	Ω
Sperrstrom							
bei $U_R = 5 V$:	$\mathbf{I}_{\mathbf{R}}$	≦.	500	500	200	200	nA
Sperrverzugsladung	;	,				·	,
beim Umschalten							
$von I_F = 10 mA$							
$\mathbf{auf} \ \mathbf{U}_{\mathbf{R}} = 5 \ \mathbf{V}$,					
$(R = 500 \Omega):$	$Q_{\mathbf{S}}$	≦		60	00		рC
Kleinsignal- kapazität							
bei $U_R = 0$,					

рF

250

BZX 75/C...

